

SECRET

本発明は、半導体素子と、該半導体素子の上に形成された絶縁層と、該絶縁層の上に形成され該半導体素子の有する電極と電気的に接続した外部接続端子とを有する半導体装置であって、前記絶縁層のエッジから前記絶縁層の厚さがほぼ同じである平坦部に至るまでの領域において電源用配線もしくはグランド用配線の配線パターンの種類と信号用配線の配線パターンの種類とが異なるものである。